PCT

国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

世界知的所有権機関



(51) 国際特許分類7

G03F 7/023, 7/004, H01L 21/027

A1

(11) 国際公開番号

WO00/34829

(43) 国際公開日

2000年6月15日(15.06.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/06729

(22) 国際出願日

1999年12月1日(01.12.99)

(30) 優先権データ

特願平10/351581

1998年12月10日(10.12.98)

(71) 出願人 (EP: (AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE); CN KRについてのみ) クラリアント インターナショナル リミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.)[CH/CH] CH-4132 ムッテンツ1 ロートハウスシュトラーセ61 Muttenz, (CH) (71) 出願人 (日本についてのみ) クラリアント ジャパン株式会社

(71) 出願人(日本についてのみ)
 クラリアントジャパン株式会社(CLARIANT (JAPAN) K.K.)[JP/JP]
 〒113-8662東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 薄田謙二(SUSUKIDA, Kenji)[JP/JP] 西川雅人(NISHIKAWA, Masato)[JP/JP] 〒437-1496 静岡県小笠郡大東町千浜3810

クラリアント ジャパン株式会社内 Shizuoka, (JP)

荒野明男(ARANO, Akio)[JP/JP]

〒562-0045 大阪府箕面市瀬川2丁目18番8号 第3モンセリバー201号室 Osaka, (JP)

(74) 代理人

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号 ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: POSITIVELY PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54)発明の名称 ポジ型感光性樹脂組成物 ~

$$\begin{pmatrix} (HO)_{c} & & & \\ (R_{2})_{d} & & & \\ (R_{3})_{b} & & & \\ (R_{1})_{b} & & & \\ (R_{3})_{f} & & \\ (R_{3})_{f} & & & \\ (R_{3})_{f} & & & \\ (R_{3})$$

$$-(CH_2)_i$$
 $(R_0)_b$
(II)

(57) Abstract

A positively photosensitive resin composition which exhibits high sensitivity and a high resolving power, can form good patterns and attain a high aspect ratio and an excellent throughput in the production, and is reduced in the process dependence of dimensional accuracy. This composition comprises (i) a photosensitive novolak resin prepared either by reacting an alkali-soluble novolak resin freed from low-molecular-weight components by fractionation with an o-naphthoquinonediazide compound or by subjecting a reaction product of an alkali-soluble novolak resin with an o-naphthoquinonediazide compound to fractionation to thereby free the reaction product from low-molecular-weight components and (ii) a low-molecular compound having a phenolic hydroxyl group.

(57)要約

本発明は、高感度、高解像力で、良好なパターンを形成することができ、高アスペクト比を有するとともに製造時のスループットも優れ、寸法精度のプロセス依存性も小さいポジ型感光性樹脂組成物である。

このポジ型感光性組成物は、(i)分別処理により低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂と o ーナフトキノンジアジド化合物との反応生成物またはアルカリ可溶性ノボラック樹脂と o ーナフトキノンジアジド化合物との反応生成物を分別処理することにより低分子量成分を除去した分別処理物からなる感光性ノボラック樹脂、および(ii)フェノール性水酸基を有する低分子化合物を含有する。

```
PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)
                                            ドエスフフガ英ググガ
ニトインンン ナジナ
スペィラボ国レルー
チジャルー
AE アラブ首長国連邦
AL アルバニア
AM アルメニア
AT オーストリア
AU オーストラリア
A2 アゼルバイジャン
BA ボズニア・ヘルツェゴビナ
                                                                                    スウングン
スウェーデン
スウンガポーア
スログファンス
スロブラ・レ
                                       バルバドス
                                                                                                                             セネガル
スワジランド
チャード
トーゴー
      ベルキー
ブルギナ・ファソ
ブルガリア
                                             ッルンフ
ガーナ
ガンピア
ギニア・ピサオ
ギリシャ
                                                                               MA
MC
MD
                                                                                                                       ŤĎ
TG
     タジキスタン
タンザニア
ギギクハイア・ヤテリンド
                                                                                                                             ッレザニア
トルクメニスタン
トルコ
                                                                                                                       TR トルコ
TT トリニグ・トバゴ
リニダインド・トグラング
リクラング
US 米ス
リス グイニスタン
VN グイエースラン
VN ユーアフグエ
ス ジン
                                                                               MMRWXELOZLTO
NNNNPPR
```

明細書

ボジ型感光性樹脂組成物

5 技術分野

本発明は、新規なポジ型感光性樹脂組成物に関し、さらに詳細には、 半導体製造、LCDパネルの液晶表示装置の表示面作成、サーマルヘッ ドなどの回路基板の製造等に好適な、感光性ノボラック樹脂を含有する ポジ型感光性樹脂組成物に関する。

10

15

20

25

背景技術

LSIなどの半導体集積回路や、LCDパネルの液晶表示装置の表示面の作成、サーマルヘッドなどの回路基板の製造等を初めとする幅広い分野において、微細素子の形成あるいは微細加工を行うために、従来からフォトリソグラフィー法が用いられている。フォトリソグラフィー法においては、レジストパターンを形成するためにポジ型またはネガ型感光性樹脂組成物が用いられている。これら感光性樹脂組成物の内、ポジ型感光性樹脂組成物としては、アルカリ可溶性樹脂と感光剤としてのキノンジアジド化合物を含有する組成物が最も広く用いられている。この組成物は、例えば「ノボラック樹脂/キノンジアジド化合物」として、特公昭54-23570号公報(米国特許第3,666,473号明細書)、特公昭56-30850号公報(米国特許第4,115,128号明細書)、特別的55-73045号公報、特開昭61-205933号公報、特開昭62-51459号公報等多くの文献に種々の組成のものが記載されている。

これらノボラック樹脂とキノンジアジド化合物を含む組成物は、これ

10

15

20

25

までノボラック樹脂および感光剤の両面から研究開発が行われてきた。 ノボラック樹脂の観点からは、新しい樹脂の開発は勿論であるが、従来 知られた樹脂の物性などを改善することにより、優れた特性を有する感 光性樹脂組成物を得ることもなされている。例えば、特開昭60-14 0235号公報、特開平1-105243号公報には、ノボラック樹脂 に、ある特有の分子量分布をもたせることにより、また特開昭60-9 7347号公報、特開昭60-189739号公報、特許第25903 42号公報には、低分子量成分を分別除去したノボラック樹脂を用いる ことにより優れた特性を有する感光性樹脂組成物を提供する技術が開示 されている。

これまでの種々の技術開発により、数多くのキノンジアジド化合物含有ポジ型感光性樹脂組成物が実用化されるとともに、今までの研究開発により感光性樹脂膜厚と解像線幅のアスペクト比もおよそ5:1にまで改善されてきている。

一方、半導体素子の集積回路の集積度は、年々高まっており、半導体素子等の製造においては、サブミクロン以下の線幅のパターンの加工が要求されるようになってきている。特にこのような超微細な加工が要求される用途においては、解像力はもとより、良好なパターンの再現性も求められ、さらには製造コストの面から、製造時のスループット(単位時間当たりの収量)を向上させることも求められている。このため感光性樹脂組成物の高感度化、寸法精度のプロセス依存性が小さいことも重要な条件となっている。しかし、従来知られた感光性樹脂組成物は、いずれもこれら全ての条件を同時に満たすものはなく、問題があった。

本発明は、これら従来から要望されていた全ての特性を同時に満たす 感光性樹脂組成物を提供すること、すなわち、高感度、高解像力で、良 好なパターンを形成することができ、高アスペクト比を有するとともに 製造時のスループットも優れ、寸法精度のプロセス依存性も小さい感光 性樹脂組成物を提供することを目的とするものである。

発明の開示

10

15

5 本発明者らは、鋭意研究、検討を行った結果、特定の感光性ノボラック樹脂と特定の溶解抑止剤とを含有するポジ型感光性樹脂組成物を用いることにより上記目的を達成することができることを見出し、本発明を成したものである。

すなわち、本発明は、(i)低分子量成分が分別処理により除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂とoーナフトキノンジアジド化合物との反応生成物またはアルカリ可溶性ノボラック樹脂とoーナフトキノンジアジド化合物との反応生成物を分別処理することにより低分子量成分を除去して得た分別処理物からなる感光性ノボラック樹脂と、(ii)下記一般式(I)で表されるフェノール性水酸基を有する低分子化合物からなる溶解抑止剤を含有することを特徴とする感光性樹脂組成物に関する。

$$(HO)_{c}$$

$$(R_{2})_{d}$$

$$(R_{1})_{b}$$

$$(R_{1})_{b}$$

$$(R_{2})_{d}$$

$$(OH)_{a}$$

$$(R_{3})_{f}$$

$$(R_{3})_{f}$$

$$(R_{3})_{f}$$

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 および R_7 は、各々独立して、 20 H、 C_1 ~ C_4 のアルキル基、 C_1 ~ C_4 のアルコキシ基、シクロヘキシ

10

15

20

4

ル基、または式:

$$CH_2$$
 (CH_2)
 (R_g)

で表される基を表し、 R_8 はH、 $C_1 \sim C_4$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_4$ のアルコキシ基またはシクロヘキシル基を表し、mおよびnは、各々、0、1または2であり、a、b、c、d、e、f、gおよびhは、a+b ≤ 5 、 $c+d \leq 5$ 、 $e+f \leq 5$ 、 $g+h \leq 5$ を満たす0または $1\sim 5$ の整数であり、iは0、1または2である。)

以下、本発明を更に詳細に説明する。

本発明の感光性ノボラック樹脂を製造するための原料として用いられる、低分子量成分が分別処理により除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂は、フェノール類の少なくとも1種とホルマリンなどのアルデヒド類とを重縮合することによって得られるノボラック型のフェノール樹脂を分別処理して、低分子量成分を除去することにより製造される。

このアルカリ可溶性ノボラック樹脂を製造するために用いられるフェノール類としては、例えば o ークレゾール、p ークレゾールおよびmークレゾールなどのクレゾール類、3,5ーキシレノール、2,5ーキシレノール、2,3ーキシレノール、3,4ーキシレノールなどのキシレノール類、2,3,4ートリメチルフェノール、2,3,5ートリメチルフェノール、2,4,5ートリメチルフェノール、3,4,5ートリメチルフェノールなどのトリメチルフェノール類、2ーtーブチルフェノールなどのtーブチルフェノール類、2ーメトキシフェノール、2,3ージメトキシフェノール、2

10

20

25

、 5 ージメトキシフェノール、 3、 5 ージメトキシフェノールなどのメトキシフェノール類、 2 ーエチルフェノール、 3 ーエチルフェノール、 4 ーエチルフェノール、 2、 3 ージエチルフェノール、 3、 5 ージエチルフェノール、 2、 3、 5 ートリエチルフェノール、 3、 4、 5 ートリエチルフェノールなどのエチルフェノール類、 0 ークロロフェノール、 mークロロフェノール、 pークロロフェノール、 2、 3 ージクロロフェノール、 1 ールなどのクロロフェノール類、 レゾルシノール、 2 ーメチルレゾルシノールなどのクロロフェノール類、 レゾルシノール、 5 ーメチルレゾルシノールなどのレゾルシノール類、 5 ーメチルカテコールなどのカテコール類、 5 ーメチルピロガロールなどのピロガロール類、 ビスフェノールA、 B、 C、 D、 E、 Fなどのビスフェノール類、 2、 6 ージメチロールー p ークレゾールなどのメチロール化クレゾール類、 αーナフトール、 βーナフトールなどのナフトール類などを挙げることができる。これらは単独でまたは複数種の混合物として用いられる。

また、アルデヒド類としては、ホルマリンの他、サリチルアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロロアセトアルデヒドなどが挙げられ、これらは単独でまたは複数種の混合物として用いられる。

これらフェノール類の少なくとも1種とホルマリンなどのアルデヒド類との重縮合は、例えば蓚酸を触媒として用いる従来周知あるいは公知の方法により行われる。この重縮合反応により得られたノボラック樹脂中の低分子量成分を除去する分別処理方法としては、公知の任意の方法を採用することができる。分別処理方法としては、例えば、異なる溶解性を有する2種の溶剤中でノボラック樹脂を分別する液ー液分別法や、低分子量成分を遠心分離により除去する方法等を挙げることができる。また、ノボラック樹脂の低分子量成分の除去は、アルカリ可溶性ノボラ

10

15

20

25

ック樹脂と o ーナフトキノンジアジド化合物を反応させた後で行っても よいが、これらを反応させる前に実施する方が、分別処理時の加熱によ って感光剤が失活する恐れがないためおよび安全上好ましい。なお、反 応物の分別処理は、ノボラック樹脂の分別処理と同様の方法により可能 である。

本件発明における低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂は、以下の「ノボラック樹脂の溶解速度の測定法」で測定される、2.38重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液に対するノボラック樹脂の溶解速度が、10~180Å/secであることが必要で、20~150Å/secであることが好ましい。溶解速度が、10Å/sec未満の場合は、低感度化、溶解残りの原因となり、また十分な解像性が得られないし、溶解速度が、180Å/secより大きいときは現像後の膜減りが大きく良好なパターンを得ることが難しい。

(ノボラック樹脂の溶解速度の測定法)

ノボラック樹脂20gを80gのエチルラクテート/nープチルアセテート(85/15)混合溶媒に溶解した後、0.5μmのテフロンフィルターでろ過し、得られた樹脂溶液をリソテックジャパン社製スピンコーター(LARC ULTIMA-1000)により、HMDS処理した4インチシリコンウェハーに、100℃、90秒間ホットプレートにてベークした後、約1μmの樹脂膜が得られるよう塗布する。100℃、90秒間ホットプレートにてベークした後、膜厚を大日本スクーリーン社製膜厚測定装置(ラムダエース)にて正確に測定する。次いで、得られたシリコンウェハーを23℃に保持されたクラリアントジャパン社製アルカリ現像液(AZ® 300MIFデペロツパー、2.38重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液)に浸漬し、ウェハー上の樹脂膜が完全に溶解する時間を測定し、膜圧と溶解時間からノボラック

10

15

20

25

樹脂の溶解速度を算出する。

一方、本発明の感光性ノボラック樹脂を製造するための原料として用 いられるoーナフトキノンジアジド化合物は、従来感光性樹脂組成物の 感光剤としてあるいは感光剤を製造するために用いることが知られ、ノ ボラック樹脂と反応した後においてもその感光性を保持するものであれ ば何れのものでもよい。このような o - ナフトキノンジアジド化合物と しては、例えば1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸クロリ ド、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド、1, 2 ーナフトキノンジアジドー6-スルホン酸クロリドなどの1.2-ナフ トキノンジアジドスルホン酸ハライド類を挙げることができる。これら o-ナフトキノンジアジド化合物は、単独で用いることもできるし、2 種以上を混合して用いることもできる。本発明の感光性ノボラック樹脂 は、単一の感光性ノボラック樹脂であってもよいし、2種以上の感光性 ノボラック樹脂の混合物であってもよい。感光性ノボラック樹脂が2種 以上の感光性ノボラック樹脂の混合物である場合、ノボラック樹脂と各 単一のoーナフトキノンジアジド化合物とを反応させ、その後これら2 種以上の感光性ノボラック樹脂を混合して製造してもよいし、あるいは 前もって混合したo-ナフトキノンジアジド化合物をノボラック樹脂と 反応させて製造してもよいが、各々単独にノボラック樹脂と反応させた 後に混合したものが好ましい。本発明において好ましく用いられるo-ナフトキノンジアジド化合物は、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸クロリド単独もしくは1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸クロリドと1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 クロリドとの組み合わせである。

アルカリ可溶性ノボラック樹脂とo-ナフトキノンジアジド化合物と

10

15

20

25

の反応は、例えばアルカリ可溶性ノボラック樹脂と o ーナフトキノンジアジドスルホン酸クロリドとを溶剤に溶解し、この溶液に有機アミン溶液を滴下する方法など従来公知の何れの方法によってもよい。本発明の感光性ノボラック樹脂は、低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂に対する o ーナフトキノンジアジド化合物の反応置換率が、該ノボラック樹脂の水酸基の水素原子に対して、3~25モル%であるものが好ましく、さらには4~15モル%であるものがより好ましい。反応置換率が3モル%未満では、目的とする解像性が得られ難くなり、また25モル%より多い場合には、ポジ型パターンに現像残りが生じる傾向が強くなるからである。

また、本発明の感光性樹脂組成物の溶解抑止剤として用いられる、 上記一般式(I)で表されるフェノール性水酸基を有する低分子化合物 としては、例えば、4, 4', 4''ーメチリジントリスフェノール、2, 6-ビス[(2-ヒドロキシー5-メチルフェニル) メチル] - 4-メ **チルフェノール、4, 4'ー[1-[4-[1-(4-ヒドロキシフェ** ニル)-1-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノール、 4, 4', 4''-エチリジントリスフェノール、4-[ビス(4-ヒド ロキシフェニル)メチル]-2-エトキシフェノール]、4,4'-□[(2-ヒドロキシフェニル) メチレン] ビス [2, 3-ジメチルフェ ノール]、4, 4'ー [(3ーヒドロキシフェニル) メチレン] ビス [2 $\forall f = [2, 6 - i \forall f = 1], 2, 2' - [(2 - 1)]$ ドロキシフェニル)メチレン]ビス[3,5-ジメチルフェノール]、 2, 2'-[(4-ヒドロキシフェニル) メチレン] ビス[3,5-ジ メチルフェノール]、4,4'-[(3,4-ジヒドロキシフェニル)メ チレン] ビス [2, 3, 6 - トリメチルフェノール]、4 - [ビス (3

10

20

25

ーシクロヘキシルー4ーヒドロキシー6-メチルフェニル) メチル] ― 1, 2-ベンゼンジオール、4, 6-ビス[(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)メチル]-1,2,3-ベンゼントリオール、4 , 4' - [(2-ヒドロキシフェニル) メチレン] ビス「3-メチルフ ェノール]、4、4''-(3-メチル-1-プロパニル-3-イリ ジン) トリスフェノール、4, 4', 4'', 4'''ー(1, 4ーフェニレ ンジメチリジン)テトラキスフェノール、2,4,6-トリス[(3. 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)メチル]-1,3-ベンゼン ジオール、2,4,6ートリス[(3,5-ジメチルー2-ヒドロキシ フェニル) メチル] -1, 3-ベンゼンジオール、4, <math>4'-[1-[4 - [1 - [4 - E]] + [4 - E]] + [4 - [4 - E]]チルフェニル)メチル]フェニル]-1-メチルエチル]フェニル]エ チリデン]ビス[2,6-ビス(ヒドロキシ-3-メチルフェニル)メ チル]フェノールなどを挙げることができる。これらのフェノール性水 酸基を有する低分子化合物は、感光性ノボラック樹脂100重量部に対 15 して通常2~20重量部、好ましくは5~15重量部用いられる。

本発明の感光性ノボラック樹脂およびフェノール性水酸基を有する低 分子化合物である溶解抑止剤は、溶剤に溶解されてポジ型感光性樹脂組 成物とされる。これら成分を溶解させる溶剤としては、エチレングリコ 「一ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル等の エチレングリコールモノアルキルエーテル類、エチレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルア セテート等のエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、 プロピレングリコールモノメチルエーテル、ブロピレングリコールモノ エチルエーテル等のプロピレングリコールモノアルキルエーテル類、プ ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコ

10

15

20

25

ールモノエチルエーテルアセテート等のプピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、乳酸メチル、乳酸エチル等の乳酸エステル類、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、メチルエチルケトン、2°ーペプタノン、シクロペキサノン等のケトン類、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン等のアミド類、γーブチロラクトン等のラクトン類などが挙げられる。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上の混合物として用いられる。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物には、必要に応じ、キノンジアジド 基を含む感光剤を配合することができる。これらの感光剤は、ナフトキ ノンジアジドスルホン酸クロリドやベンゾキノンジアジドスルホン酸ク ロリドと、これら酸クロリドと縮合反応可能な官能基を有する低分子化 合物または高分子化合物とを反応させることによって得られる。この酸 クロリドと縮合可能な官能基としては、水酸基、アミノ基などが挙げら れるが、特に水酸基が好適である。水酸基を含む化合物としては、例え ば、ハイドロキノン、レゾルシン;2、4-ジヒドロキシベンゾフェノ ン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,4,6-トリヒ ドロキシベンゾフェノン、2、4、4'-トリヒドロキシベンゾフェノ ン、2、3、4、4-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2、2'、4、 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2,2',3,4,6'-ペ ンタヒドロキシベンゾフェノン等のヒドロキシベンゾフェノン類;ビス (2, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ビス(2, 3, 4-トリヒ ドロキシフェニル)メタン、ビス(2,4-ジヒドロキシフェニル)プ ロパン等のヒドロキシフェニルアルカン類;4,4',3'',4''ーテ. トラヒドロキシー3, 5, 3',5'ーテトラメチルフェニルメタン、 4, 4', 2'', 3'', 4''ーペンタヒドロキシー3, 5, 3', 5'ー テトラメチルトリフェニルメタン等のヒドロキシトリフェニルメタン類

20

25

等が挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、また2種以上を組合 わせてもよい。

本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じ従来感光性樹脂組成物の 添加剤として用いられている、染料、接着助剤、界面活性剤等を配合す 5 ることができる。染料としては、例えばメチルバイオレット、クリスタ ルバイオレット、マラカイトグリーン等が、接着助剤としては、アルキ ルイミダゾリン、酪酸、アルキル酸、ポリヒドロキシスチレン、ポリビ ニルメチルエーテル、t-ブチルノボラック、エポキシシラン、エポキ シポリマー、シラン等が、界面活性剤としては、例えばポリプロピレン 10 グリコールまたはポリオキシエチレンラウリルエーテル等のポリグリコ ール類およびその誘導体等の非イオン系界面活性剤、例えばフロラード (商品名、住友3M社製)、メガファック (商品名、大日本インキ化学 工業社製)、スルフロン(商品名、旭硝子社製)等のフッ素含有界面活 性剤、例えばKP341 (商品名、信越化学工業社製)等の有機シロキ サン界面活性剤が挙げられる。

さらに、本発明の感光性樹脂組成物は、TiN,SiN,SiONな どの無機反射防止膜や、AZ® BARLi、AZ® BARLi II (何 れもクラリアントジャパン社製)などの有機反射防止膜と組み合わせて 用いることもできる。

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、例えば反射防止膜が設けられた シリコンウエハー等の基板上に、スピンコートなどにより途布され、感 光性樹脂組成物が塗布された基板はベーキングされて基板上に感光性樹 脂膜が形成される。この感光性樹脂膜が形成された基板は、紫外線、遠 紫外線、X線、電子線などの放射線により露光された後、アルカリ性現 像剤によって現像されて、高解像で、パターン形状の良好なレジストパ ターンが形成される。

図面の簡単な説明

第1図は、合成例1で製造されたノボラック樹脂AのGPCチャート図である。また第2図は、ノボラック樹脂Aを分別処理して得られたノボラック樹脂BのGPCチヤート図である。

5

発明を実施するための最良の形態

以下に本発明をその実施例をもって具体的に説明するが、本発明の態 様はこれらの実施例にのみ限定されるものではない。

合成例1 ノボラック樹脂の合成および分別処理

m-クレゾール80g、p-クレゾール120g、37%ホルマリン10 水溶液112gおよび蓚酸0.32gを、攪拌機、コンデンサーおよび 温度計を付した1リットルのセパラブルフラスコに仕込み、攪拌しなが ら100℃まで昇温し、16時間反応させた。その後温度を200℃ま で上げ、徐々に1mmHgまで減圧して、水、未反応のクレゾールモノ マー、ホルムアルデヒドおよび蓚酸等を除去した。その後溶融したノボ 15 ラック樹脂をフラスコより取り出し、室温まで冷まして、反応生成物を 固化、回収した。得られたノボラック樹脂Aの分子量をゲルパーミエー ションクロマトグラフィー (GPC) により測定した。測定結果を図1 に示す。ノボラック樹脂Aのポリスチレン換算重量平均分子量は6,8 00、分散度(Mw/Mn)は10.5、ダイマー、トリマー、テトラ 20 マーの含有率はそれぞれ12.1%、4.2%、4.5%であった。ま た、2.38重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液に対する溶 解速度は199Å/secであった。

次に、このノボラック樹脂 A 1 0 0 g をメタノール 2 3 4 g に完全に 25 溶解させた後、これに純水 8 3. 5 g を攪拌しながら徐々に加えた。 1 0 分間攪拌後、更に純水 8 3. 5 g を攪拌しながら徐々に加えた。攪拌

20

25

中得られた沈殿物をろ過により取り出した。更に、このメタノール溶解、純水洗浄およびろ過を繰り返し行い、白色の樹脂分を得た。この樹脂分を40℃に加熱し、減圧下で48時間乾燥させてノボラック樹脂Bを得た。ノボラック樹脂Bの分子量をGPCにより測定した。測定の結果を図2に示す。ノボラック樹脂Bのポリスチレン換算重量平均分子量は8,000、分散度は7.9、ダイマー、トリマー、テトラマーの含有率はそれぞれ7.1%、2.2%、3.3%であった。また、2.38重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液に対する溶解速度は40 &/secであった。

10 なお、GPC測定は次のように行った。

カラムとして、昭和電工社製GPCカラム(KF-804 1本、KF-802 2本、KF-801 1本)を用い、流量1.0m1/分、移動相に液体クロマトグラフイー用テトラヒドロフラン(THF)、カラム温度 40 \mathbb{C} にて測定した。

15 合成例 2 感光性ノボラック樹脂の合成

攪拌機、滴下ロートおよび温度計を付した1リットルの3つロセパラブルフラスコに、合成例1で調製した分別ノボラック樹脂B60g、1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニルクロライド6.71g、アセトン250gを仕込み、攪拌して完全に溶解させた。次にフラスコをアイスバスに浸し、フラスコの内容物を15℃に調整した後、アイスバスを取り除いた。次にアセトン25m1にトリエチルアミン3.83m1を溶解し、滴下ロートに仕込んだ後、これを1時間かけてフラスコ中へ滴下した。更に10分間攪拌した後、フラスコ内容物をろ過し、トリエチルアミン塩酸塩を除去した。次いで、ろ液を0.1 N塩酸水溶液400m1中へ攪拌しながら徐々に滴下し、析出物を得た。この析出物を水洗、ろ過した後、40℃減圧下で42時間乾燥して、感光性ノボ

ラック樹脂Cを得た。

実施例1

5

10

15

20

感光性ノボラック樹脂 C 4 5 g、溶解抑止剤として下記式 (D-1) で示される低分子化合物 5 g、界面活性剤メガファック R-0 8 (大日本インキ化学工業社製) O. O 5 g を、エチルラクテート/n - ブチルアセテート (85/15) 混合溶媒 8 O g に溶解した。この溶液をO. 5 μ m のテフロンフィルターでろ過し、ポジ型感光性樹脂組成物 1 を得た。

上記で得られたポジ型感光性樹脂組成物1を、下記「感光性樹脂組成物の評価」にしたがって、感度、解像度、パターン形状、スカム形成性、マイクログルービング特性の評価を行った。結果を表1に示す。

(感光性樹脂組成物の評価)

塗布装置としてリソテックジャパン社製スピンコーター(LARC ULTIMA-1000)を用い、感光性樹脂組成物をHMDS処理した4インチシリコンウエハーに、 110° C、120秒間ホットプレートにてプリベークを行った後、約 6μ mのレジスト膜が得られるように塗布する。塗布後、 110° C、120秒間ホットプレートにてプリベークを行い、形成された感光性樹脂膜の膜厚を大日本スクリーン社製膜厚測定装置(ラムダエース)にて測定し、このシリコンウエハーを365nmの露光波長を有する縮小投影露光装置(日立製作所社製、LD-5015iCW、NA=0.50)を用いて露光量を段階的に変化させて露

光する。露光後クラリアントジャパン社製アルカリ現像液(A Z® 3 0 0 M I F デペロッパー、2.3 8 重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液)を用い、23℃の条件下で5分間浸漬現像してポジのレジストパターンを得る。この結果から、以下の評価基準により、感度、解像度、パターン形状、スカム形成性、マイクログルービング特性の評価を行う。

(1) 感度

0.80μmの孤立スペースがレチクル設計通りに形成できる露光エネルギー。

10 (2)解像度

15

上記露光量にて解像される最小パターン寸法。

(3) パターン形状

レジストパターンが形成されたウェハー上の孤立スペースの断面形状を走査型電子顕微鏡(SEM)により観察し、膜減りが無く、かつ孤立スペースのボトム寸法に対して基板からレジスト膜厚の2/3の高さでのパターン寸法の増加率が+10%未満であるものを〇、同+10%以上15%未満を△、同+15%以上または膜減りがあるものを×とする

(4) スカム

20 限界解像度における孤立パターン形状を走査型電子顕微鏡 (SEM) により観察し、基板上およびレジストパターンとの界面に現像残りが見られないものを〇、現像残りが見られるものを×とする。

(5) マイクログルービング

限界解像度における孤立スペースパターン形状を走査型電子顕微鏡 (SEM)により観察し、レジストパターンと基板との界面でパターン の食い込みが見られないものを〇、パターンの食い込みが見られるもの を×とする。

実施例2

溶解抑止剤として式 (D-1) で示される低分子化合物に替えて、下記式 (D-2) で示される低分子化合物を用いる以外は実施例1と同様にして、ポジ型感光性樹脂組成物2を得た。

実施例1と同様の方法で、ポジ型感光性樹脂組成物2の感度、解像度、パターン形状、スカム形成性、マイクログルービング特性の評価を行った。結果を表1に示す。

10 比較例 1

15

分別処理を施した感光性ノボラック樹脂C50g、界面活性剤メガファックR-08 (大日本インキ化学工業社製) 0.05gをエチルラクテート/ブチルアセテート (85/15) 混合溶媒80gに溶解した。この溶液を0.5μmのテフロンフィルターでろ過し、ポジ型感光性樹脂組成物3を得た。実施例1と同様の方法で、ポジ型感光性樹脂組成物3の感度、解像度、パターン形状、スカム形成性、マイクログルービング特性の評価を行った。結果を表1に示す。

比較例2

分別処理前のノボラック樹脂Aを用い、感光性ノボラック樹脂Cの合成と同様の方法により、感光性ノボラック樹脂Eを得た。得られた感光性ノボラック樹脂E50g、界面活性剤メガファックR-08(大日本インキ化学工業社製)0.05gをエチルラクテート/ブチルアセテート(85/15)混合溶媒80gに溶解した。この溶液を0.5μmのテフロンフィルターでろ過し、ポジ型感光性樹脂組成物4を得た。実施例1と同様の方法で、ポジ型感光性樹脂組成物4の感度、解像度、パターン形状、スカム形成性、マイクログルービング特性の評価を行った。結果を表1に示す。

10 比較例3

5

感光性ノボラック樹脂E45g、溶解抑止剤として式(D-1)で示される低分子化合物5g、界面活性剤メガファックR-08(大日本インキ化学工業社製)0.05gをエチルラクテート/ブチルアセテート(85/15)混合溶媒80gに溶解した。この溶液を0.5 μ mのテフロンフィルターでろ過し、ポジ型感光性樹脂組成物5を得た。実施例1と同様の方法で、ポジ型感光性樹脂組成物5の感度、解像度、パターン形状、スカム形成性、マイクログルービング特性の評価を行った。結果を表1に示す。

表 1

į	感光性ノボラック樹脂		低分子フェノール化合物		感度	解像度	パターン	スカム	マイクロ
	種類	添加量	種類	添加量	(mJ/cm²)	(µ m)	形状		グルーピング
実施例 1	С	90	D-1	10	620	0.55	0	0	0
実施例 2	С	90	D-2	10	585	0.55	0	0	0
比較例 1	С	100	-	-	920	0.80	×	×	×
比較例 2	E	100	-	_	730	0.60	0	×	×
比較例 3	E	90	D-1	10	530	0.70	Δ	×	×

20

15

表1から明らかなように、本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、感度

、解像度に優れ、パターン形状も良好で、スカムの形成もなく、またマイクログルービング特性も優れていることが分かる。

発明の効果

5 以上詳述したように、本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、高感度、高解像力で、良好な形状を有するパターンを形成することができ、高アスペクト比を有するとともに製造時のスループットも優れ、寸法精度のプロセス依存性も小さいため、今後さらに徴細化が進行すると考えられる半導体素子の製造あるいはLCDパネルの液晶表示装置の表示面の作成、サーマルヘッドの回路基板の製造等のレジスト材料として極めて有用である。

産業上の利用可能性

以上述べたように、本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、半導体素子 の製造、LCDパネルの液晶表示装置の表示面の作成、サーマルヘッド などの回路基板の製造等の際のフォトレジスト材料として好適に用いられる。

請求の範囲

1. (i)分別処理により低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂と o ーナフトキノンジアジド化合物との反応生成物またはアルカリ可溶性ノボラック樹脂と o ーナフトキノンジアジド化合物との反応生成物を分別処理することにより低分子量成分を除去して得た分別処理物からなる感光性ノボラック樹脂、および(ii)下記一般式(I)で表されるフェノール性水酸基を有する低分子化合物を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

10

5

$$\begin{pmatrix} (HO)_{c} & R_{4} \\ (R_{2})_{d} & R_{5} \end{pmatrix}_{m} \begin{pmatrix} (OH)_{a} \\ (R_{1})_{b} & R_{6} \\ (R_{7} & (R_{3})_{f} \end{pmatrix}_{n}$$

$$(1)$$

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 および R_7 は、各々独立して、H、 $C_1 \sim C_4$ のアルキル基、 $C_1 \sim C_4$ のアルコキシ基、シクロヘキシル基、または式:

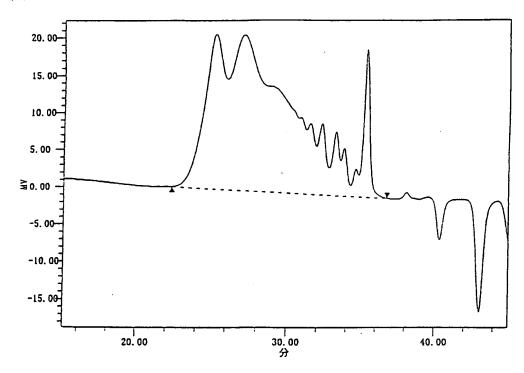
$$-(CH_2)_i$$
 $(R_8)_h$

15

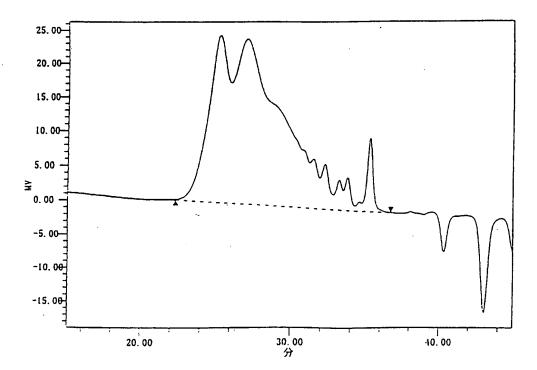
で表される基を表し、 R_8 はH、 $C_1 \sim C_4$ のTルキル基、 $C_1 \sim C_4$ のTルコキシ基またはシクロヘキシル基を表し、MおよびTは、各々、T0

- 、1または2であり、a、b、c、d、e、f、gおよびhは、a+b ≤ 5 、c+d ≤ 5 、e+f ≤ 5 、g+h ≤ 5 を満たす0または1 ~ 5 の整数であり、i は0、1または2である。)
- 2. 上記分別処理により低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボ ラック樹脂の2. 38重量%水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液に 対する溶解速度が、10~180Å/secであることを特徴とする請求項1記載のポジ型感光性樹脂組成物。
- 3. 上記分別処理により低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂は、3,000~15,000のポリスチレン換算重量平均 分子量を有し、また感光性ノボラック樹脂は、該アルカリ可溶性ノボラック樹脂の水酸基の水素原子に対するo-ナフトキノンジアジド化合物の反応置換率が、3~25モル%であることを特徴とする請求項1記載のポジ型感光性樹脂組成物。
- 4. 上記一般式(I)で表されるフェノール性水酸基を有する低分子化 15 合物が、分別処理により低分子量成分が除去されたアルカリ可溶性ノボラック樹脂100重量部に対して、0.5~20重量部含有される請求項1記載のポジ型感光性樹脂組成物。

第1図



第2図



6/14/2007, EAST Version: 2.1.0.14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/06729

		101/8	133700123			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G03F7/023, G03F7/004, H01L21/027						
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	S SEARCHED					
Minimum d Int .	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G03F7/00-7/42, H01L21/027					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku koho 1996-2000						
Electronic d	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		1			
Category*	Citation of document, with indication, where ap JP, 62-160444, A (Mitsubishi Pe		Relevant to claim No.			
•	16 July, 1987 (16.07.87), Claims; example of compound on examples (Family: none)	1-4				
Y	JP, 6-67418, A (Japan Synthetic 11 March, 1994 (11.03.94), Claims; Par. Nos. [0028],[0039] (Family: none)		1-4			
Y	JP, 8-129255, A (Fuji Photo Fil 21 May, 1996 (21.05.96), Claims; Par. No. [0056] & US, 5629128, A & EP, 7108 & DE, 69510888 E		1-4			
Y	JP, 10-69077, A (Shin Etsu Cher 10 March, 1998 (10.03.98), Claims (Family: none)	1-4				
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume conside "E" earlier date "L" docume cited to special docume means "P" docume than the	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later expriority date claimed actual completion of the international search lebruary, 2000 (29.02.00)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 21 March, 2000 (21.03.00)				
	ailing address of the ISA/					
	nese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' G03F 7/023, G03F 7/004, H01L 21/027

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' G03F 7/00 - 7/42, H01L 21/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2000年

日本国登録実用新案公報

1994-2000年

日本国実用新案登録公報

1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

O. 10E/		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 62-160444, A (三菱油化株式会社), 16.7月.1987 (16.07.87), 特許請求の範囲、第5頁~第6頁の合成例2及び5, 実施例 (ファミリーなし)	1 – 4
Y	JP, 6-67418,A(日本合成ゴム株式会社), 11.3月.1994(11.03.94), 【特許請求の範囲】,【0028】,【0039】-【0042】 (ファミリーなし)	1-4
	JP, 8-129255, A (富士写真フィルム株式会社), 21.5月.1996 (21.05.96),	

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 29.02.00 国際調査報告の発送日 21.03.00 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 単便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3273

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

	四次小州 直 十以口	国际山頂番号「C丁/JF9	77 0 0 1 2 3
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	ナーその関連する第冊の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	【特許請求の範囲】、【0056】	い、この内にする国内や女小	1-4
	&US, 5629128, A&EP, 71	0886, A	1 4
	&DE, 69510888, E		
	JP, 10-69077, A (信越化学工	業株式会社),	
Y	10.3月.1998 (10.03.9 【特許請求の範囲】	8),	1-4
	(ファミリーなし)		- *
	·		
		·	
		•	
		ļ	
		_	
		·	

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)